第五卷第二期	7上	而允	±N	<u>vu</u>	-HD (Vol.5, No.2
1966年5月	旺	政	īnta.	- f -	10	May, 1966

ZnO-Al₂O₃-SiO₂-B₂O₃系統微晶玻璃的电性

張英华 張玉峰 殷之文**

(中国科学院硅酸盐化学与工学研究所)

摘要

在ZnO-Al₂O₃-SiO₂-B₂O₃系統中选取了三个 典型的徽晶玻璃組成, 制取了不同淬冷条件 的玻璃和不同晶化条件的微晶玻璃。在全面测定材料电导率和介电性能的基 础上, 推荐了可能 作为优良电介质材料 的 $\lambda 6307$ 微晶玻璃 ($\rho_{V(180*C)} \approx 10^{12}$ 欧姆·厘米, $tg\delta_{(j=10.6 m/9)} = 1.5 \times 10^{-3}$, $\delta_{(j=10.6 m/9)} = 5.4$)。同时,根据微观结构和析出晶相含量的理論計算,从二液分相的观点 对上述玻璃在淬冷和微晶化过程中电性的变化規律作了說明。

一、引言

利用液相线下微观分相原理,秦晨、閔嗣桂^[1]在ZnO-Al₂O₃-SiO₂系統中,获得了 具有良好性能的微晶玻璃材料。这种材料具有低膨胀系数良好的机械强度和介电性能, 有可能作为电絕緣介质材料用于电子工业和其他方面。本文系統地研究了鋅系典型微晶 玻璃的电性,并从二液分相的观点对电性机理作了一定的探討,为闡明和改进材料的电 学性能提供了資料。

二、实驗方法

1. 玻璃組成和样品的制备

在ZnO-Al₂O₃-SiO₂-B₂O₃系統中选取了析出不同晶相的三个組成,大致分成两个 类型:(1)高硅含硼玻璃№6300和№6307,析出的晶相为尖晶石(ZnO·Al₂O₃); (2)高硼高鋅玻璃№6401,析出的晶相为莫来石(3Al₂O₈·2SiO₂)。它們的組成列 于表1。用工业用石英砂、苏州土、碳酸鋅和三級化学純試剂硼酸、碳酸鋇和紅丹作为 原料。由玻璃分析表明玻璃中№2⁰杂质含量为0.2~0.4重量%。

将原料按照玻璃的計算組份配料,其中,№6401玻璃的氧化硼揮发校正量为10%。粉料混合过篩二次,以确保粉料組分的均匀。№6300和№6307是用油炉和閉口坩堝进行熔制,坩堝为 *BS*-74 粘土坩堝,容量为10公斤,熔制制度分別为1500~1520°C保溫15小时和1470~1480°C 保溫10小时。 №6401玻璃是用500克容量的鉑銠坩堝在硅炭棒电炉中进行熔制,熔制溫度为1350°C保溫6小时。除№6401玻璃在成型时由肉眼发現有分相現象

^{*} 本文于1965年11月8日收到。

^{**} 参加工作者尚有上海科技大学宋脩玉、柴进发同志。秦晨同志供給了部份試样。

媗	号	氧化物 (克分子%)							
		ZnO	Al ₂ O ₃	SiO2	BaO	РЬО	B ₂ O ₃ *		
N	6300	20.00	17.00	63.00	-	—	9.00		
N	6307	18.00	17.00	63.00	1.00	1.00	9.00		
N	6401	51,50	22.60	25.90	-	—	34.00		

表 1 玻璃的組成

▪ B₂O₃含量另外加入。

外,其余玻璃都未发現分相現象。全部試样都經过退火,直至用应力仪观察玻璃內应力 消失为止。

2. 微晶玻璃的制备

用梯度炉进行样品析晶条件的測定,結果見图1。根据玻璃微晶化的溫度区間选择 不同的微晶化制度,然后将玻璃試样埋于煅烧过的苏州土中,在溫度波动为±2~3℃的 馬弗炉中按規定的微晶化热处理制度进行处理,就获得了微晶玻璃試样。



图 1 玻璃的析晶情况

3. 淬冷处理

淬冷处理是将熔体直接淬冷成型。其方法是将不同溫度的高溫玻璃熔体淬冷至不同 溫度的鉄模中成型和烘炼。根据淬冷速度的不同分快、中、慢三种淬冷情况。快淬冷是 将1600°C~1470°C的高溫熔体淬冷至室溫的鉄模中,并不进行任何热处理。中淬冷是将 高溫熔体淬冷至100°C的鉄模中,并在100°C的炉溫中緩慢冷却至室溫。慢淬冷是将玻璃 液浇注在400°C左右的鉄模中,并将玻璃埋于加热至100°C左右的草灰中自然冷却。

4.物性測定

用排水法測定玻璃的密度,測定誤差±0.01克/厘米⁸。直流电导是用德国MG-2型多 次反射精密检流計的直接偏轉法測定,測定誤差±5%。試样为二面抛光涂敷石墨作电极 的 \$ 50 × 2毫米的图片。介电系数和介质損耗是用上海无线电仪器厂的615-A型优值計进 行測試,測試誤差,电容量为±1.5微微法,Q值为12~20%。試样为 \$ 50 × 2毫米經二 面抛光烧渗銀极的圓片。玻璃的低溫粘度用拉絲法測定,誤差为±10%。电子显微鏡相 片是用国产01型电子显微鏡拍摄的。試样的制备方法是将 1%浓度的 HF 酸溶液使玻璃 抛光面腐蝕1~3分钟,清洗干净后,用复膜技术制取的。

三、实驗結果

1.直流电导

全部組成的直流电导测試結果和計算所得的电导激活能列于表2。实驗結果指出:



图 2 №6300玻璃在不同淬冷条件下的透明玻璃的电导率 1-1470°C熔制快淬冷;2-1550°C熔制快淬冷;3-1600°C熔制快淬冷;4-1550°C熔制中淬冷;5-1600°C 熔制中淬冷;6-1550°C熔制慢淬冷;7-1600°C熔制慢淬冷;8-1600°C熔制720°C热处理; 9-1550°C熔制720°C热处理

№6300透明玻璃的电导率随着热历史不同有很大的 差別(图2)。1600°C、1550°C、 1470°C快淬冷的試样具有几乎相同的电导率和电导激活能。随着淬冷速度的减慢,玻璃 在分相溫度区間停留时間的增长,电导显著增大。慢淬冷的玻璃与在 720°C 热处理的玻 璃具有相近的电导率,它比快淬冷的玻璃的电导率大10⁸倍。№6307玻璃在720°C热处理 过程中电导率随溫度的变化異常灵敏,因而不同玻璃試样的电导率出現明显的分散性 (图4中的1、2)。№6401玻璃虽然在成形时已由肉眼观察到分相現象,但是玻璃的电导率 郤仍接近于№6300快淬冷試样的电导率,并且各試样之間并不具有电导率的分散性。

№6300和№6307玻璃在微晶化后的电导率比720℃热处理后的透明 玻 璃只有很小的 增加。随着热处理条件的变更,微晶玻璃电导率几乎不变,电导激活能也几乎保持恒定 (图3、4,表2)。№6401玻璃晶化后与透明的分相玻璃具有相同的 电导 率 和电导 激活能(图5,表2)。

在煤气炉强还原气氛下熔制和在CO还原气氛下热处理的 №6300 的微晶玻璃与空气



图 3 №6300玻璃在不同晶化条件下的电导率

1-1550°C熔制快淬冷透明玻璃; 2-1550°C熔制720°C热处理透明玻璃; 3-800°C保溫15小时微晶玻璃; 4-900°C保溫1小时微晶玻璃; 5-900°C保溫5小时微晶玻璃; 6-900°C保溫15小时微晶玻璃; 7-还原 气氛熔制与处理的微晶玻璃; 8-剩余玻璃相

中熔制热处理的試样具有相同的电导率(图3,图中未注明熔制与处理气氛的都是在空 气气氛中进行熔制、热处理的試样)。 測定了 №6300 微晶玻璃残余玻璃相(附录 I)的 电导率,它与№6300微晶玻璃的电导率具有相同的数量級和接近相等的电导激活能。

2,介电性能

不同晶化条件下的 $l_{0}6300$ 和 $l_{0}6307$ 微晶玻璃在頻率 $f=10^{8}$ 周/秒时的介电系数 $\varepsilon'=5.3\sim5.5$,介质損耗 $tg\delta=1.5\sim2.0\times10^{-3}$ (表2)。玻璃晶化前后的介电性能极少差異。

3.密度与电子显微鏡图片

所有組成的玻璃在微晶化后的密度仅仅只有 很 小 的增加。 在不同晶化热处理条件 下,№6300和№6307微晶玻璃的密度几乎保持不变(表 2)。

由电子显微鏡图片(图6~9)观察到微晶玻璃的微观結构。对于№6300玻璃来讲, 900°C保溫15小时和800°C保溫15小时的微晶玻璃的晶相都是孤立地存在于玻璃相中。在 800°C的微晶化条件下,观察到明显的微不均匀区域,小晶粒呈团地分布在大晶粒的包围中。随着温度升高至900°C,这种現象消失了,晶粒尺寸則变得更大。在經过720°C保 溫1小时热处理的玻璃,已观察到微观分相現象。№6401微晶玻璃的晶相尺寸較大,含 量較多,不能明确判断晶相是否是孤立相。





1-1480°C熔制720°C热处理透明玻璃(1); 2--1480°C熔制720°C热处理透明玻璃(2); 3--850°C保温15小时 微晶玻璃; 4--900°C保温1小时微晶玻璃; 5--900°C保温5小时微晶玻璃; 6--900°C保温15小时微晶玻璃

編 号	样品处理条件	电导率 σ(Q·cm) ⁻¹	电导激活能 φ(ev)	介电系数* &	介质損耗* tgð×10*	密度 d(g/cm ³)
№ 6300	1550°C熔制快淬冷至100°C的透明玻璃	(250°C) 2.37×10 ⁻¹³	1.26		-	
	1550°C熔制720°C1小时退火透明玻璃	1.10×10^{-10}	1.18	5.9	25	2.75
	800℃保温5小时微晶玻璃	1,54×10 ⁻¹⁰	1.17	5.4	20	2.83
	800℃保溫15小时微晶玻璃	2.20×10^{-10}	1.16	5.3	19	2.82
	900°C保溫1小时微晶玻璃	1.62×10 ⁻¹⁰	1.11	5.4	16	2.84
	900 ℃ 保溫 5 小时微晶玻璃	1.85×10 ⁻¹⁰	1.13	5.3	15	2.83
	900℃保温15小时微晶玻璃	1.92×10 ⁻¹⁰	1.12	5.3	20	2.83

赛 2 玻璃和微晶玻璃的直流电导率、电导激活能、介电性能与密度

編	号	样品处理条件	电导率 σ(Ω·cm) ⁻¹	电导激活能 φ(ev)	介电系数* 6	介质損耗* tgð×10*	密 度 d(g/cm ³)
№6307	1480°C熔制720°C1小时退火透明玻璃(1)	8.20×10^{-12}	1.08	6.0	15	2.80	
	1480°C熔制720°C1小时退火透明玻璃(2)	3.71×10^{-12}	1.08	6.0	15	2.80	
	207	850℃保溫15小时微晶玻璃	7.30×10^{-11}	1.11	5.3	17	2.87
	307	900℃保温1小时微晶玻璃	1.01×10^{-11}	1.10	5.4	15	2.85
		900℃保溫 5 小时微晶玻璃	8.50×10^{-11}	1.14	5.5	12	2.86
	900℃保溫15小时微晶玻璃	8.20×10 ⁻¹¹	1.05	5.4	16	2.85	
№ 6401	1380°C熔制620°C1小时退火透明玻璃	$(400 ^{\circ}\text{C})$ 6.06×10 ⁻¹²	1.65		-	3.00	
	735℃保溫 5 小时微晶玻璃	8.00×10^{-12}	1.65	6.4	37	3.05	

在室溫和10°周/秒下进行測試。

,





图 6 №6300, 720°C热处理1小时 透明玻璃×5000



图 8 №6300, 900°C保温15小时 微晶玻璃×5000



图 7 №6300,800°C保溫15小时 微晶玻璃×5000



图 9 №6401, 735°C保温 5 小时 微晶玻璃×5000

四、討論

No 6300玻璃在肉眼未能察覚微覌分相的透明玻璃的情况下,玻璃的电导率随着淬冷 速度的不同有显著的差異。从1600°C至1470°C的溫度下快淬冷至室溫的透明玻璃具有相 近的电导率,可以設想在1600°C~1470°C的高溫下,玻璃熔体在此溫度范围內具有几乎完 全相同的积聚状态。随着淬冷速度的减慢,玻璃熔体在分相区間內停留时間的加长,电 导率迅速增大。将1600°C快淬冷的試样經过720°C的热处理, 电导率急剧增大, 与慢淬 冷的試样相当。这种現象不难从鋅系微晶玻璃的微晶化机理得到說明。正如秦晨、閔嗣 桂⁽¹⁾所指出的, 鋅系微晶玻璃是不具有晶核剂的, 而是 由于鋅系微晶玻璃的組份接近 二液相区域,玻璃結构內已存在或可能发展成微覌的二液結构, 其中之一是化学組成和 晶体接近、几何构形和晶体近似的微相, 由于它的析晶傾向大, 易于析出成晶相而轉变 成微晶玻璃。对于这种微晶化过程的玻璃, 分相作用应該看作 是 玻 璃 微晶化的初級阶 段,对电导的影响应呈現与微晶化过程相似的規律。由720℃保温1小时热处理的№6300 透明玻璃的电子显微鏡图片清楚地看到在玻璃中存在着分相現象。測定該溫度时玻璃的 低溫粘度为2.2×10¹¹泊,650°C时玻璃的粘度为2.6×10¹⁸泊,而在765°C 时玻璃已开始 析晶(图1)。由此可知,当玻璃粘度略低于退火点的粘度时,玻璃已有足够明显的分 相現象产生。

值得注意的是№6300微晶玻璃随着晶化热处理条件的变更,电导率几乎沒有改变。 根据№6300玻璃析出晶相含量的計算(附录 I)指出,在目前选取的最低热处理溫度和 最短热处理时間的800°C保溫 5小时晶化处理的微晶玻璃中,ZnO 和 Al₂O₈ 已几乎全部 进入析出的ZnO · Al₂O₈尖晶石晶相中,玻璃密度随着热处理条件的变 更保持不变,这 表明溫度增高和时間的延长对晶体析出含量沒有多大影响,热处理溫度的增高仅仅使玻 璃的微观結构有了改变。晶化溫度愈高,晶粒尺寸愈大。

№6307微晶玻璃的电性变化情况与№6300微晶玻璃完全一致,只是它組份中的PbO, BaO进入了残余玻璃相,使玻璃的电导載流子遇到了 Pb²⁺, Ba²⁺ 填隙离子的阻挡,使 电导略有降低。

№6401玻璃在晶化前后的电导率变化与前二种玻璃有着不同的規律。首先,該种玻 璃在肉眼观察到微观分相的情况下玻璃試样的电导率仍旧保持了与№6300快淬冷試样相 当的数量級,幷且随着微晶化沒有出現电导率的急剧下降,相反仍能維持原来的数值。 微晶化机理相同而产生的結果不同,应該由晶化后剩余玻璃相組份的不同来加以說明。 №6300玻璃的SiO₂含量較高在析出了ZnO・Al₂O₂尖晶石晶体后,剩余玻璃相变成了一 个更富硅的硼硅玻璃(附录Ⅰ),在測定了 №6300 微 晶 玻璃剰余玻璃相的电导率后(图 3),发現它与№6300微晶玻璃的电导率具有相同的数量級。№6300玻璃析出的尖晶石 (ZnO·Al₂O₈)是个半导晶体。为了了解析出 晶相对微晶玻璃电导率的影响,由文献数 据計算了ZnO·Al₂O₃尖晶石的电导率σ_{250 ⋅ c}=1.48×10⁻¹⁰(欧姆·厘米)⁻¹(附录Ⅱ)。由上 面的数据可以知道Me300玻璃在微晶化后,不論从析出晶相和剩余玻璃相的角度来看, 都可使电导增大。但是根据在还原气氛中熔制和热处理的№6300微晶玻璃与卒气中熔制 和处理的微晶玻璃具有相当的电导率的实驗結果,更由于析出晶体的含量仅为微晶玻璃 总体积的24%左右,而且是个孤立相,因此可以认为,№6300、№6307这一类型的玻璃 經微晶化后电导率的增大不象是因为析出尖晶石半导晶体后产生电子电导所引起的,而 是由于剩余玻璃相組份的改变增大了离子电导的能力所造成的。在这些玻璃中原存在有 . 少量的 Na+、K+离子, 由于晶化后剩余玻璃相中的这类离子載流子浓度相对增高,且 二价金属离子 Zn²⁺已几乎全部进入晶相,因而显著地增高了电导。根据同样的理由, 也就不难解释添加了少量二价离子添加剂的№6307玻璃的电导要比№6300为小的事实。 这是由于这些少量添加离子阻碍了电导载流子的跃迁所造成的。

№6401微晶玻璃剩余玻璃相基本上是一个ZnO-B₂O₃玻璃(附录II),它的电导率 与 №6401 原始透明玻璃几乎相等(图 5),而析出晶体莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂)亦是 一个絕緣晶体,具有很小的电导。因此,№6401微晶玻璃与透明玻璃电导接近相等。与 №6300一样,由于玻璃相含量較大,因此可以认为剩余玻璃相决定了№6401微晶玻璃的 电导率。

5卷2期

五、結論

1.N₀6307微晶玻璃較N₀6300微晶玻璃具有更为良好的电性能。 $\rho_{r(180 \cdot c)} \approx 10^{12}$ (欧姆· 厘米), $tg\delta_{(t-10^{6} / t^{0})} = 1.5 \times 10^{-8}$, $\varepsilon_{(t-10^{6} / t^{0})} = 5.4$, 不論从工艺上和电性上来讲, 都能够作为具有实用价值的电介质材料。

2.利用二液相分相成核的鋅系微晶玻璃,它的电性能随着不同晶化热处理条件的变 化极不灵敏,因此改变热处理条件不能作为改进鋅系微晶玻璃电性能的有效方法。

3.不同热历史的透明玻璃所以产生不同的电导率是由于产生了二液分相作用的緣故。无碱的鋅系玻璃中典型的微晶玻璃的电导主要取决于剩余玻璃相。

针 录

Ⅰ.№6300微晶玻璃析出晶相含量和剩余玻璃相組成的計算:

計算方法:

1)析出ZnO·Al₂O₃尖晶石15克分子%时, 剩余玻璃相組成为(克分子%): SiO₂ 81.80; Al₂O₃ 0.72; B₂O₃ 12.80; ZnO 4.57。

2)根据干福熹[2]的密度加和原則,求得剩余玻璃相的密度为2.28克/厘米3。

3)根据Me6300玻璃800°C保溫 5小时的热处理所获得的微晶玻璃的密度(2.83克/厘米³)和尖晶石晶体的密度(4.60克/厘米³)用加和法求得析出晶体含量X=24.4体积%。

4)将假設析出的ZnO·Al₂O₃尖晶石的重量百分数折算成体积百分数。

5) 假設的析出晶体含量与計算所得析出晶体含量偏差+0.6%。

6)同理,假設析出晶体为12.5%(克分子百分数),求得的晶体含量为18%(体积)与假設的20%(体积) 的偏差为+2.0%(体积)。

7)故得实际晶体的析出含量是介于23.8~20.0%(体积)之間。而其中能以ZnO·AI₂O₃尖晶石析出的組分 已几乎全部进入晶相。

8)实际测定的剩余玻璃相电导率为析出ZnO·Al₂O₃尖晶石为15克分子%时的組份。

I. $ZnO \cdot Al_2O_3$ 尖晶石晶体的电导 率^[3] 文献数据: $\sigma_{(900 \cdot C)} = 5.36 \times 10^{-6} (\Omega \cdot cm)^{-1}$, $\varphi = 0.86ev_o$ 故得 $\sigma_{(250 \cdot C)} = 1.48 \times 10^{-19} (\Omega \cdot cm)^{-1}$ 。

■.№6401微晶玻璃剩余玻璃相的电导率:

由于无法計算硼酸盐玻璃的理論密度,因此无法計算 №6401 玻璃中析出的晶体含量。假設能以3 $\Delta I_2O_3 \cdot 2SiO_2$ 莫来石晶体析出的組份几乎已全部析出,則剩余玻璃相为 ZnO-B₂O₃-SiO₂玻璃。因为 SiO₂ 含量 极少,故基本上 是一个ZnO-B₂O₃ 玻璃。由文献^[4]查得与 №6401 剩余玻璃相組份相近的 ZnO 51.5 克分子%, B₂O₈ 48.5 克分 子%玻璃, $\rho_{V}(450 \cdot C) = 2.51 \times 10^{10}(G \cdot cm), 9 = 1.59ev, 而№6401微晶玻璃的电阻率<math>\rho_{V}(450 \cdot C) = 1.73 \times 10^{10}(G \cdot cm),$ $\varphi = 1.65ev, 二者是非常符合的。$

参考文献

[1] 秦晨、閔嗣桂, 硅酸盐学报, 5[1]26(1966)。

[2] 干福熹, 硅酸盐学报, 1[2]55(1962)。

[3] T.E.Bradborn and G.R.Rigby, Trans. Brit. Cer. Soc., 52, 417 (1953).

[4] Chikara Hirayama, J. Am. Cer. Soc., 44[12]602(1961).

ELECTRICAL PROPERTIES OF GLASS-CERAMICS IN THE SYSTEM ZnO-Al₂O₃-SiO₂-B₂O₃

Chang Ying-hua Chang Yu-fo Ying Chih-wen (Institute of Chemistry and Technology of Silicates, Academia Sinica) Abstract

Glasses of three typical Glass-ceramic compositions in the quaterary system ZnO $-Al_2O_3 - SiO_2 - B_2O_3$ were selected and prepared under varied quenching and devitrified conditions. On the bases of measurement of electrical conductivity and dielectrical properties, the glass-ceramic composition Ne 6307 may be recommended as a suitable dielectrical material $(\rho_{V(180°c)}=10^{12}Q\cdot cm, \ tg\delta_{(j-10°c/s)}=1.5\times10^{-3}, \ \epsilon_{(j-10°c/s)}=5.4)$. The results of the microscopic investigation and the theoretical calculation of crystalline phase content devitrified indicate that the change of electrical properties of above-mentioned glasses during quenching and devitrified processes can be explained from the veiw point of liguid immiscibility hypothesis.